

Предлагаемый способ комплексной оценки структурного совершенства структуры монокристаллов, используемых для производства полупроводниковых и оптоэлектронных устройств, заключается в том, что определяют характеристику изменения брэгговского угла, максимальное значение  $R_m$  характеристики, ширину характеристики на уровне  $0,2R_m$  от оси и соотношение между указанными параметрами, по которому оценивается степень совершенства монокристалла. Настоящее изобретение позволяет повысить точность анализа и использовать для анализа образцы, имеющие различную толщину.